

日期：111年10月21日
單位：研究發展處

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

- 一、文陳閱後，公告於電子公布欄、本組、本處及本校最新消息，並e-mail副知全校教師知照。
- 二、欲參加者，請依來函說明自行至活動系統報名。
- 三、文存。

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
行政組員 張明芬 10210804		
副教授兼組長 江信毅 10210947		代為決行
教授兼研究發展處長 宋振銘 10210947		教授兼研究發展處長 宋振銘 10210947

裝

訂

線



檔 號：

保存年限：

國家科學及技術委員會 函

機關地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：李蕙瑩 研究員
電話：02-2737-7150
傳真：02-2737-7607
電子信箱：vvlee@nstc.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國111年10月19日
發文字號：科會科字第1110064971號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本會與美國國家科學基金會(NSF)共同徵求「臺美先進半導體晶片設計與製作合作研究計畫(ACED Fab Program)」並將於111年11月15日及23日舉辦學術研討會(線上會議)，詳如說明，請查照轉知。

說明：

- 一、旨揭臺美雙邊合作研究計畫徵件案業以本會111年9月28日科會科字第1110060546號函知貴單位，並於本會網站「計畫徵求專區」公告。
- 二、為使更多半導體領域之學者專家參與本次共同徵件，本會與美方NSF將於11月15日及23日二日上午8時，共同舉辦「臺美先進系統晶片設計(ACED Fab)學術研討會(線上會議)」，鏈結臺美半導體領域學者互動交流，會議資訊及報名網址如下：<https://opportunityacedfab.asee.org/>，歡迎有興趣學者專家報名參加。

正本：專題研究計畫受補助單位（共301單位）

副本：本會工程處、科教國合處、駐美國代表處科技組、駐波士頓辦事處科技組、駐休士頓辦事處科技組、駐舊金山辦事處科技組、駐洛杉磯辦事處科技組



主任委員吳政忠

國立中興大學

